

FIB聚焦离子束测试试验，第三方聚焦离子束FIB检测机构

产品名称	FIB聚焦离子束测试试验，第三方聚焦离子束FIB检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

FIB（聚焦离子束，Focused Ion beam）是将离子源（大多数FIB都用Ga，也有设备具有He和Ne离子源）产生的离子束经过离子枪加速，聚焦后作用于样品表面。

FIB聚焦离子束测试标准

- 1、JY/T 0583-2020 聚焦离子束系统分析方法通则
- 2、SY/T 7410.2-2020 岩石三维孔隙结构测定方法 第2部分：聚焦离子束切片法

FIB聚焦离子束测试范围（部分）

1、IC芯片电路修改：

用FIB对芯片电路进行物理修改可使芯片设计者对芯片问题处作针对性的测试，以便更快更准确的验证设计方案。若芯片部份区域有问题，可通过FIB对此区域隔离或改正此区域功能，以便找到问题的症结。

2、Cross-Section 截面分析：

用FIB在IC芯片特定位置作截面断层，以便观测材料的截面结构与材质，定点分析芯片结构缺陷。

3、 Probing Pad :

在复杂IC线路中任意位置引出测试点, 以便进一步使用探针台(Probe- station) 或 E-beam 直接观测IC内部信号。

4、 FIB透射电镜样品制备 :

这一技术的特点是从纳米或微米尺度的试样中直接切取可供透射电镜或高分辨电镜研究的薄膜。试样可以为IC芯片、纳米材料、颗粒或表面改性后的包覆颗粒, 对于纤维状试样, 既可以切取横切面薄膜也可以切取纵切面薄膜。

5、 材料鉴定 :

材料中每一个晶向的排列方向不同, 可以利用透穿对比图像进行晶界或晶粒大小分布的分析。另外, 也可加装EDS或SIMS进行元素组成分析。

FIB聚焦离子束作用

- 1、 产生二次电子信号取得电子像.此功能与SEM (扫描电子显微镜) 相似
- 2、 用强电流离子束对表面原子进行剥离,以完成微、 纳米级表面形貌加工。
- 3、 通常是以物理溅射的方式搭配化学气体反应, 有选择性的剥除金属, 氧化硅层或沉积金属层。

FIB聚焦离子束测试流程

- 1、 沟通需求 (在线或电话咨询) ;
- 2、 寄样 (邮寄样品支持上门取样) ;
- 3、 初检 (根据客户需求确定具体检测项目) ;
- 4、 报价 (根据检测的复杂程度进行报价) ;
- 5、 签约 (双方确定--签订保密协议) ;

6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是FIB聚焦离子束测试检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可信性验证等技术服务，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。